

次世代パワーエレクトロニクス用基板の 先進加工技術最前線（&産総研パワエレ見学会）

SiC, GaN, ダイヤモンドといったワイドバンドギャップ材料が、次世代の光・パワー半導体用材料として注目されています。しかし、これらの材料は硬度が極めて高く、また化学的・熱的にも強いという材料特性から基板化加工が極めて難しく課題が山積しています。そこで本研究会では、これらワイドバンドギャップ材料開発の最新動向や最新のウェハ加工技術について各専門家の方々に講演を行っていただきます。

その後、産総研 西事業所内の先進パワエレ関連施設（結晶成長・ウェハ加工 他）の見学会を行います。

主催：砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日時：2019年10月4日(金) 13:00~18:00

会場：産総研西事業所 TIA 連携棟 1階 TIA-nano ホール

(茨城県つくば市小野川 16-1)

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/west/tsukuba_map_w.html

交通：つくばエクスプレス；つくば駅で下車。

「つくば駅」からのアクセス方法には、バス（「連絡便（無料）」、「路線バス（片道：250円）」）と「タクシー」があります。

所要時間は10分程度です。詳しくは以下をご参照ください

https://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/tsukuba_w_express.html



13:00~13:05	開会挨拶	委員長	池野順一
13:05~13:55	講演1 「 SiCウェハ加工の最前線 — 生産プロセスの全方位での最適化 — 」	株式会社デンソー	長屋正武
13:55~14:45	講演2 「 GaN基板の加工技術 」	長岡技術科学大学	曾田英雄
14:45~15:05	<休憩>		
15:05~15:55	講演3 「 産業利用を指向したダイヤモンド作製技術の最新動向 」	産業技術総合研究所	山田英明
15:55~18:00	産総研 西 先進パワエレ関連施設 見学会：見学概要説明&リード	産業技術総合研究所	加藤智久
18:00~18:30	交流会場へ移動（送迎バス）		
18:30~20:30	技術交流会： つくば 樓外樓 学園店（つくば駅前）		

参加費

- ・研究会：当専門委員会会員：無料，非会員：15,000円 ※会員は5人まで、非会員は2人まで研究会に参加できます。
- ・技術交流会：2人/社まで無料，3名目からは会員・非会員問わず5,000円/人を徴収致します。

申込締切日：2019年9月19日(木)

(注) 当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。

問合せ/申込先：当専門委員会事務局 田附宙美宛

・FAX：048-829-7046, E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp

・申し込み用紙はこちらから→<http://spe.mech.saitama-u.ac.jp/mysite5/application2017ver2.pdf>

※見学会への参加希望も申込時にご回答ください。尚、講演会場⇒見学場所までは、所内工事のため迂回路（約1.2km）を徒歩移動していただくこととなります。あらかじめご了承ください。